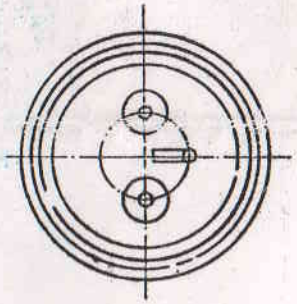
ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ
П307В, П308, П309

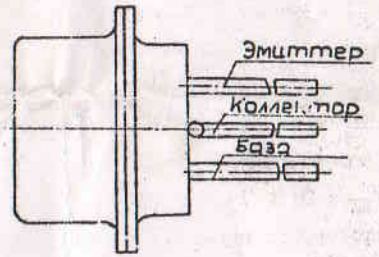
П309

ЭТИКЕТКА

100

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы П307В, П308, П309 в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в радиовещательных приемниках, приемо-усилительной и другой радиотехнической аппаратуре.





Масса не более 2 г

4461004.14

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ t окр.ср.=(+25±10)°С

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма					
		П307В		П308		П309	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1	2	3	4	5	6	7	8
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ($R_{ЭБ}$= 10 кОм $U_{КЭ}$ = 80 В для П307В $U_{КЭ}$ = 120 В для П308,П309)	$I_{КЭR}$		50		50		50
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ}$ = 80 В для П307В $U_{КБ}$ = 120 В для П308,П309)	$I_{КБО}$		20		20		20
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ}$ = 3 В)	$I_{ЭБО}$		10		10		10
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала ($U_{КБ}$ = 20 В, $I_{Э}$ = 10 мА)	$h_{21Э}$	50	150	30	90	16	60
Сопротивление насыщения в режиме малого сигнала, Ом ($I_{К}$ = 15 мА, $I_{Б}$ = 3 мА)	$r_{КЭнас}$		250		200		150
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}$ = 20 В, $I_{Э}$ = 4 мА, f = 10МГц)	$\|h_{21Э}\|$	2		2		2	
Входное сопротивление в режиме малого сигнала, Ом ($U_{КБ}$ = 20 В, $I_{Э}$ = 10 мА)	$h_{11б}$		70		70		70

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

13,9479

золото г

в том числе золото 0,00002272 г/мм на 3 выводах длиной 30 ± 2 мм.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов П307В, П308, П309 соответствуют техническим условиям 3.365.059ТУ1.

ШТАМП ОТК

Перепроверка произведена _____

дата

ШТАМП ОТК

ПК 21

НОЯ 1991

conector.by